

PRESSEMITTEILUNG

02_2020_D

Anvo-Systems Dresden präsentiert SPI nvSRAM für den Automotive-Temperaturbereich

Dresden, März 2020 – Die Anvo-Systems Dresden GmbH, die Spezialistin für nicht-flüchtige Speicherprodukte, erweitert ihr Produktportfolio um das 64 Kb nvSRAM (non-volatile SRAM) ANV32E61ASA66 mit Serial Peripheral Interface (SPI). Der Baustein sorgt für die Speicherung aller Daten bei einem unvorhersehbaren Abfall der Betriebsspannung und erhöht damit die Sicherheit eines modernen Industriesystems. Die non-volatile Data Retention (Datenerhalt) von zehn Jahren stellt eine hohe Zuverlässigkeit sicher.

Der nicht-flüchtige Speicherbaustein ANV32E61ASA66 wurde für den Automotive-Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C spezifiziert und ist für alle Anwendungen, die in einem weiten Temperaturbereich arbeiten, prädestiniert. Beispiele dafür sind intelligente Systeme für die Industrieautomatisierung, die Robotik, das Industrial IoT-Umfeld, die Gebäudeautomatisierung, Smart Metering und Black Boxes (z. B. für Fahrzeuge).

Für einen platzsparenden Einbau ist das nvSRAM ANV32E61ASA66 in einem kompakten, RoHS entsprechenden 8 Pin 150 mil SOIC-Gehäuse untergebracht. Der Baustein kann ab sofort über Anvo-Systems Dresden bzw. die Vertriebspartner weltweit bezogen werden.

Das nvSRAM ANV32E61ASA66 mit einer Speicherkapazität von 64 Kb ist intern als 8k Worte x 8 Bit organisiert. Jede SRAM-Speicherezelle integriert ein nicht-flüchtiges SONOS Speicherelement für die Speicherung aller Daten im PowerStore-Betrieb bei einem plötzlichen Abfall der Betriebsspannung. Erreicht die Betriebsspannung wieder ihren Soll-Wert, werden automatisch die Daten erneut im SRAM gespeichert. Der nicht-flüchtige Speicher mit einer Taktrate von 66 MHz bietet wie ein Standard-SRAM unbegrenzte Lese-

und Schreibzyklen (R/W Endurance). Spezielle Sicherheitsfunktionen, wie z.B. Block Write Protection, Secure READ und Secure WRITE, können die Datengenauigkeit erhöhen.

Die integrierte Power Down-Funktion (Hibernate Mode) sorgt für einen geringen Stromverbrauch des Systems im Standby-Betrieb. Das serielle SPI nvSRAM ist für einen Betriebsspannungsbereich von 3,0 V - 3,6 V ausgelegt.

Über Anvo-Systems Dresden

Die in Dresden ansässige Anvo-Systems Dresden GmbH wurde 2009 als fabless Halbleiterunternehmen gegründet und hat sich auf nicht-flüchtige Speicherprodukte spezialisiert. Die Kernkompetenzen umfassen nvSRAM, FLASH, SRAM und DRAM Technologien. Die schnellen und hochzuverlässigen Systemlösungen sind für Anwendungen in der Industrie, in Hochleistungsrechnern, in der Medizin, in der Energietechnik, im Automotive-Bereich und in Kommunikationssystemen ausgelegt.

Anvo-Systems Dresden hat strategische Kooperationsverträge mit der XFAB Semiconductor Foundries AG und Melexis N.V. unterzeichnet. Das Unternehmen ist Mitglied des Semiconductor Cluster Silicon Saxony.

Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

*Anvo-Systems Dresden GmbH
Zur Wetterwarte 50
Haus 337 / B
01109 Dresden
Tel.: 0351 795 89 00
Fax: 0351 795 89 011
www.anvo-systems-dresden.com*

*Bernd Dahlheimer
Tel.: 07483 912328
bdahlheimer@anvo-systems-dresden.com*

*Technisches Redaktionsbüro
Rosemarie Krause
Leibengerstr. 29
81829 München
Tel.: 089 906637*